

Invenția se referă la electronică, în particular la tehnologia semiconductoarelor.

Sunt cunoscute, elaborate și implementate în practică multe dispozitive în baza compușilor $Zn_xIn_2S_{3+x}$ (unde $x=1, 2, 3$ și 5) [1-3].

Mai este cunoscut procedeul de obținere a peliculelor de polisulfuri care include depunerea compusului sulfidic pe un suport și prelucrarea termică ulterioară.

Neajunsurile acestui procedeu constă în utilizarea unei instalații foarte complexe și imposibilitatea obținerii materialelor sus-numite pe suprafețe mari.

Problema invenției constă în simplificarea obținerii multisulfizilor și obținerea lor pe suprafețe mari.

Procedeul, conform invenției înlătură dezavantajele menționate mai sus prin aceea că include depunerea compusului sulfidic pe un suport și prelucrarea termică ulterioară. Noutatea constă în aceea că suportul se prelucrează preliminar cu soluție de $ZnCl_2$, se usucă la temperatura de 373 K, compusul sulfidic $Zn_xIn_2S_{3+x}$ ($x = 1, 2, 3, 5$) se amestecă cu soluție de $ZnCl_2$, iar prelucrarea termică se efectuează în condiția $T \cdot t = (6,3 - 8,5)10^3$ grad·h, unde:

T - temperatura de prelucrare,

t - timpul de prelucrare.

Rezultatul invenției constă în micșorarea temperaturilor utilizate la prelucrarea termică.

Exemplu de realizare a invenției.

Pulberea compusului $ZnIn_2S_{3+x}$ ($x=1, 2, 3, 5$) se amestecă în soluție de $ZnCl_2$. Se alege suportul pe care dorim să obținem pelicula. El se curăță bine. După aceasta se prelucrează cu aceeași soluție $ZnCl_2$ și se usucă. Pe suport se depune lichidul compusului de o grosime dorită, care, la rândul său, de asemenea tot se usucă. E de dorit ca operația să fie efectuată într-un timp scurt de câteva minute, pe un reșou electric închis, la temperatura ≈ 373 K. După aceasta, pelicula obținută se prelucrează termic la temperatura T grade K în timpul t ore, adică la o anumită valoare a produsului T·t exprimată în K·ore. Această operație tehnologică contribuie la creșterea adeziunii între pelicula propriu-zisă și suport, la ordonarea materialului peliculei, precum și la creșterea lui orientată, ceea ce este foarte important. La o valoare mare a produsului T·t, poate fi obținută doparea peliculei prin difuzia cu materialul suportului. De exemplu: la $T=273$ K, în $t=11$ ore obținem produsul $T \cdot t=8,5 \cdot 10^3$ K·ore, iar la $T=773$ K, în $t=8,15$ ore – $T=6,3 \cdot 10^3$ K·ore. Experiențele ne demonstrează, că acesta este intervalul optim de prelucrare. Pentru a obține sensibilitatea optimă a unui dispozitiv de aplicare anumită este bine de dopat suspensia sau de prelucrat special compusul inițial (pulberea sau cristalul masiv), iar apoi să fie utilizat. De exemplu, în cazul celulei solare este necesară o sensibilitate înaltă în domeniul vizibil al luminii cu o semilățime spectrală sporită. Această condiție poate fi creată în rezultatul dopării compusului cu Ni de o anumită concentrație. Doparea compusului $ZnIn_2S_4$ cu această impuritate, cu concentrația de $3,7 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, dă cea mai mare sensibilitate $\rho_i/\rho_1=3,0 \cdot 10^3$ și cuprinde diapazonul spectral 470 – 600 nm cu maximum la 520 nm. În acest caz valoarea aceasta este optimă, dar când compusul este nedopat special, avem $\rho_i/\rho_1=10$, cuprinzând diapazonul 490 – 520 nm cu maximum 550 nm. Această concluzie este demonstrată elocvent de datele prezentate în tabel.

Parametrii monocristalelor $ZnIn_2S_4:Ni$

Concentrația Ni, cm^{-3}	ρ_i/ρ_1 la 100 Lx	Spectrul, nm	Maximum, nm
$1,2 \cdot 10^{19}$	$7,5 \cdot 10^2$	420-520	500
$3,7 \cdot 10^{19}$	$3,10 \cdot 10^3$	470-600	530
$1,0 \cdot 10^{20}$	21	480-600	590
Nedopat	10	490-690	550

Compoziția chimică și omogenitatea peliculelor obținute a fost verificată prin examinarea lor cu ajutorul analizei reontgenostructurale și microanalizei cu microsonda electronică. În urma verificării caracteristicilor fotoelectronice ale eșantioanelor preparate s-a constatat, că ele coincid spectral cu cele ale compusului masiv, cu excepția sensibilității, care-i puțin mai mică. Pentru $ZnIn_2S_4::Ni$ la concentrația impurității $3,7 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, sensibilitatea este $\rho_i/\rho_1 \approx 10^3$. Acest rezultat se explică prin faptul că cristalele au o perfecțiune mai înaltă decât peliculele.

Așadar, procedeul propus de obținere a peliculelor multisulfizilor stratificați pe orice suport metalic, orientat și neorientat, este simplu, puțin costisitor și posibil de realizat în condiții de laborator sau întreprindere industrială. Toate procesele tehnologice se efectuează în condiții atmosferice obișnuite, prelucrarea termică la temperaturi mari poate fi înfăptuită în vid.